

2SA1106

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形トランジスタ

☆2SC2581とコンプリメンタリペアになります。

サレジンモールドケース

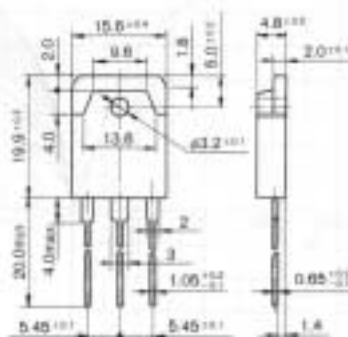
○一般用

○通信産業用

外形图

單位: mm

不燃仕度：規格UL 94V-0相当品



製品重量 約 6.0g

最大定格 ($T_{\text{a}}=25^{\circ}\text{C}$)

項 目	記 号	2SA1108	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-140	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-140	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-6	V
コレクタ電流	I_C	-10	A
ベース電流	I_B	-4	A
許容コレクタ損失	P_C	100(フランジ温度25℃)	W
接合温度	T_J	150	℃
保存温度	T_{stg}	-55~+150	℃

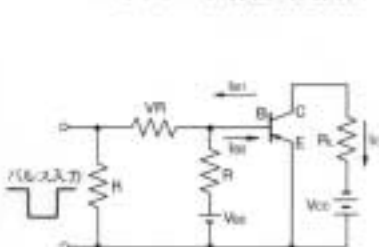
電氣的特性 (Ta=25℃)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA1106	単位
最大コレクタ遮断電流	I_{CO}	$V_{CE} = -140V$	-100	μA
最大エミッタ遮断電流	I_{EO}	$V_{ES} = -6V$	-100	μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA$	-140	V
直流電流増幅率	β_{FE}	$V_{CE} = -4V$ $I_C = -3A$	30 min	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5A$ $I_E = -0.5A$	-2.0 max	V
遮断周波数	f_T	$V_{CE} = -12V$ $I_E = 0.5A$	20 typ	MHz

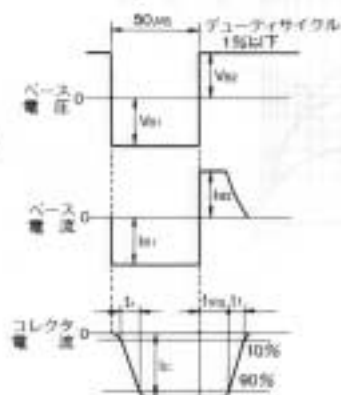
代表的スイッチング特性(エミッタ接地)

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	V_{CE} (V)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	t_i (μ s)	t_{eq} (μ s)	t_f (μ s)
-60	12	-5	5	-500	500	0.3typ	0.9typ	0.2typ

スイッチング特性測定回路



測定波形



P_c-T_a 定格

